

日程表（分科別1）

大分類分科名	3月15日(日)		3月16日(月)		3月17日(火)		3月18日(水)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
S シンポジウム								
NT1【一般公開】就活生必見！理科学の知と技術者の挑戦 ～AI×半導体の新世界～				WL1_401 13:30～16:25				
NT2【一般公開】国際性あるダイバーシティ実現へ：学術・産業の場におけるダイバーシティ&インクルージョンを考える		WL1_401 13:30～17:30						
NT3【一般公開】半導体テクノロジーはウェルビーイングを向上させられるのか？						WL1_201 13:30～18:00		
T1 Lab to Fab 2：量産化とグリーン化を突破するための半導体研究				W9_222 13:30～18:00				
T2 組織における人材育成と技術伝承：現状と今後の展望				M_B07 13:30～17:15				
T3 廃炉の未来を切り拓く放射線計測技術 – 福島第一原子力発電所における挑戦と進展 –		M_B07 13:30～16:45						
T4 誤り耐性量子計算の最前線と展望		M_178 13:30～18:20						
T5 光とキラリティー：その科学と応用		S2_203 13:30～16:55						
T6 実用化目前のメタサーフィス				S2_204 13:30～17:50				
T7 光熱変換による物理化学と量子生命科学のイノベーション				WL1_201 13:30～18:20				
T8 分布型音響センサ（DAS）による社会インフラの見える化と防災活用				M_278 13:30～16:25				
T9 技術イノベーションを加速する薄膜新材料とデバイス・プロセスの新展開								WL1_201 13:00～16:45
T10 半導体評価技術の最前線						M_B07 13:30～17:40		
T11 次世代電子源と電子ビーム技術の新展開						S2_203 13:30～17:55		
T12 プラズマが誘起する植物応答				M_374 13:30～17:55				
T13 原子層プロセス（ALP：Atomic Layer Process）の解析技術と応用技術（3）	70A_101 09:00～12:20	70A_101 13:30～18:00						
T14 磁気科学と医工融合が拓く次世代バイオメディカル				WL1_301 13:30～18:30				
T15 AI時代における大規模ストレージ・不揮発性メモリ技術の将来展望						M_374 13:30～17:35		
T16 ナノバイオテクノロジー分野におけるインフォマティクス技術の応用		WL1_301 13:30～18:20						
T17 ナノテクノロジーを駆使したバイオセンサーと2次元材料の最前線 -ヒト感染性ウイルスを迅速に検出可能なグラフェンFETセンサーによるパンデミックのない社会の実現 -		M_278 13:30～16:45						
T18 バイオ・エレクトロニクス・フォトニクスの融合によるニューロモルフックコンピューティング						WL1_301 13:30～18:15		
T19 有機分子のフィジカル空間とサイバー空間の狭間で；今、シミュレーションで解決すべき有機デバイスの課題		WL1_201 13:30～17:15						
T20 光機能材料と界面制御によるエネルギー変換研究の新展開		M_374 13:30～18:00						
T21 次世代センシング・通信を拓く微細加工・MEMS技術の新展開				M_178 13:30～17:10				
T22【一般公開】宇宙開発から宇宙産業へ：ビジネス参入へのヒントと最新の技術動向						70A_101 13:30～17:40		
T23 時空間可換性が拓く非平衡材料の新展開						WL1_401 13:30～17:20		
T24 人間 × AI × ロボティクスが拓く自律材料研究のフロンティア			70A_101 09:00～12:00	70A_101 13:30～17:40				
FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」								
FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	M_123 09:00～12:30	M_123 14:00～16:15	M_123 09:00～12:30	M_123 14:00～16:15			PA2 09:30～11:00	
KS 研究会セッション								
KS.1 固体量子センサ研究会				PB3 14:30～16:00			W9_324 09:00～12:00	W9_324 13:30～16:15
CS.5 6.2 カーボン系薄膜、KS1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション						S4_201 14:00～18:00		
KS.2 量子情報工学研究会					M_B07 09:00～11:30		S2_202 09:00～11:30	S2_202 14:00～16:45
KS4 量子エネルギー変換研究会		M_B104 14:00～18:15	SL_101 09:30～12:45	SL_101 14:00～18:30	SL_101 09:30～12:15	SL_101 13:30～15:45		
						PA7 16:30～18:00		
CS コードシェアセッション								
CS.1 2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェアセッション	S2_202 09:00～11:45	S2_202 14:00～16:45						
CS.2 3.8 テラヘルツ全般、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション			S2_204 09:15～12:00					
CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス／配線／集積化技術のコードシェアセッション					M_278 09:00～12:30			
CS.4 6.1 強誘電体薄膜、15.4 III-V族窒化物結晶のコードシェアセッション		SL_101 13:45～18:30						
CS.5 6.2 カーボン系薄膜、KS1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション						S4_201 14:00～18:00		
CS.6 6.3 酸化物エレクトロニクス、6.4 薄膜新材料のコードシェアセッション						WL2_101 13:30～16:15		
CS.7 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション						W9_323 13:30～16:15	W9_323 09:00～11:45	

日程表（分科別2）

大分類分科名	3月15日(日)		3月16日(月)		3月17日(火)		3月18日(水)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域		PB2 16:30 ~ 18:00	M_135 10:00 ~ 12:15					
1.2 教育							M_135 09:00 ~ 11:30	
1.3 新技術・複合新領域					M_135 09:00 ~ 11:45			
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境						M_135 14:00 ~ 17:30		
1.5 計測技術・計測標準				M_135 14:00 ~ 18:00				
1.6 超音波	M_135 09:30 ~ 12:00	M_135 14:00 ~ 15:45						
		PB2 16:30 ~ 18:00						
2 放射線								
2.1 放射線物理・材料開発・材料特性評価	PA4 11:30 ~ 13:00					S2_202 14:00 ~ 15:30		
2.2 発生装置・検出器開発・計測技術			S2_202 14:00 ~ 18:00	S2_202 09:00 ~ 12:30				
2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析 ※7.4 イオンビーム一般とのコードシェアセッション		S2_202 14:00 ~ 16:45						
2.4 ライフサイエンス・医療・宇宙地球環境・放射線教育						S2_201 14:00 ~ 18:00		
3 光・フotonics								
3.1 光学基礎・光学新領域	S4_201 09:00 ~ 12:00		WL1_201 09:00 ~ 12:00		WL2_301 09:00 ~ 12:00	PA1 14:30 ~ 16:00		
3.2 情報フotonics・画像工学			M_110 09:30 ~ 12:00	M_110 14:00 ~ 17:45	WL2_101 09:30 ~ 12:00	PA2 14:30 ~ 16:00		
3.3 生体・医用光学	M_110 09:00 ~ 12:00	M_110 14:00 ~ 17:15	PB1 09:30 ~ 11:00					
3.4 レーザー装置・材料			PB2 09:30 ~ 11:00		M_110 09:00 ~ 12:30	M_110 14:00 ~ 17:45		
3.5 超高速・高強度レーザー			PB3 09:30 ~ 11:00		W9_326 09:00 ~ 12:15	W9_326 13:30 ~ 18:15	W9_326 09:00 ~ 11:30	
3.6 レーザープロセス						PA3 14:30 ~ 16:00	S4_201 10:30 ~ 12:00	S4_201 14:00 ~ 17:00
3.7 光計測技術・機器	WL2_301 09:30 ~ 12:00	WL2_301 13:30 ~ 16:00	WL2_301 09:30 ~ 12:00			WL2_301 13:30 ~ 17:45		
		PA3 16:30 ~ 18:00						
3.8 テラヘルツ全般			PB4 09:30 ~ 11:00	WL2_301 13:30 ~ 17:45			WL2_301 09:00 ~ 12:00	WL2_301 13:30 ~ 16:30
CS.2 3.8 テラヘルツ全般、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学の コードシェアセッション			S2_204 09:15 ~ 12:00					
3.9 光量子物理・技術			PB5 09:30 ~ 11:00			S4_203 14:10 ~ 17:15	S4_203 09:00 ~ 10:45	
3.10 フotonics構造・現象	WL2_201 09:30 ~ 12:00	WL2_201 13:30 ~ 16:15	WL2_201 09:30 ~ 12:00	WL2_201 13:30 ~ 16:15				
		PA4 16:30 ~ 18:00						
3.11 ナノ領域光科学・近接場光学		PA1 14:30 ~ 16:00			WL2_201 09:00 ~ 12:00	WL2_201 13:30 ~ 18:00	WL2_201 09:00 ~ 11:45	WL2_201 13:15 ~ 17:00
CS.2 3.8 テラヘルツ全般、3.11 ナノ領域光科学・近接場光学の コードシェアセッション			S2_204 09:15 ~ 12:00					
3.12 半導体光デバイス		PA2 14:30 ~ 16:00	W9_326 09:00 ~ 11:45	W9_326 13:45 ~ 16:45				
3.13 シリコンフotonics・光電融合集積・光制御			PB6 09:30 ~ 11:00		WL2_401 09:00 ~ 12:00	WL2_401 13:30 ~ 17:15	WL2_401 09:00 ~ 12:00	
3.14 Optics and Photonics English Session		S4_201 14:00 ~ 17:15	PB7 09:30 ~ 11:00					
6 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜			M_278 09:00 ~ 10:45			M_278 14:00 ~ 18:15		
			PA6 11:30 ~ 13:00					
CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス／配 線／集積化技術のコードシェアセッション					M_278 09:00 ~ 12:30			
CS.4 6.1 強誘電体薄膜、15.4 III-V族窒化物結晶のコードシ ェアセッション		SL_101 13:45 ~ 18:30						
6.2 カーボン系薄膜		WL2_401 13:30 ~ 17:15	WL2_401 09:30 ~ 11:45	PB1 14:30 ~ 16:00				
CS.5 6.2 カーボン系薄膜、KS1 固体量子センサ研究会のコード シェアセッション						S4_201 14:00 ~ 18:00		
6.3 酸化物エレクトロニクス	WL2_101 09:00 ~ 11:45	WL2_101 13:30 ~ 17:00			PB1 11:30 ~ 13:00			
CS.6 6.3 酸化物エレクトロニクス、6.4 薄膜新材料のコードシ ェアセッション						WL2_101 13:30 ~ 16:15		
6.4 薄膜新材料			WL2_101 09:00 ~ 11:45	WL2_101 13:30 ~ 16:30	PA2 11:30 ~ 13:00		WL1_201 09:30 ~ 11:45	
CS.6 6.3 酸化物エレクトロニクス、6.4 薄膜新材料のコードシ ェアセッション						WL2_101 13:30 ~ 16:15		
6.5 表面物理・真空					PA3 11:30 ~ 13:00			
CS.7 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新 技術のコードシェアセッション						W9_323 13:30 ~ 16:15	W9_323 09:00 ~ 11:45	
6.6 プローブ顕微鏡			M_B104 09:30 ~ 12:30	PB2 14:30 ~ 16:00	S4_201 09:00 ~ 12:30			

日程表（分科別3）

大分類分科名	3月15日(日)		3月16日(月)		3月17日(火)		3月18日(水)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
7 ビーム応用								
7.1 X線技術		W9_326 13:30 ~ 17:45					PB3 11:30 ~ 13:00	
7.2 電子ビーム応用			S4_203 09:00 ~ 12:15	S4_203 14:00 ~ 16:30				
7.3 微細パターン・微細構造形成技術					S4_202 09:00 ~ 11:45			
7.4 イオンビーム一般 ※2.3 加速器技術・加速器質量分析・ビーム分析とのコードシェアセッション	S2_202 09:00 ~ 11:45	S2_202 14:00 ~ 16:45						
7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術								
CS.7 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション						W9_323 13:30 ~ 16:15	W9_323 09:00 ~ 11:45	
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・診断						PB3 16:30 ~ 18:00	M_103 09:00 ~ 12:30	M_103 14:00 ~ 15:45
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理					M_103 09:00 ~ 12:30	M_103 14:00 ~ 17:15	PB4 11:30 ~ 13:00	
8.3 プラズマナノテクノロジー						PB4 16:30 ~ 18:00	M_107 09:00 ~ 10:30	
8.4 プラズマライフサイエンス	PA1 09:30 ~ 11:00	M_107 14:00 ~ 18:00						
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	PA2 09:30 ~ 11:00					M_107 14:00 ~ 18:15		
8.6 Plasma Electronics English Session								M_103 16:00 ~ 16:45
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			M_374 11:00 ~ 11:45					
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体			M_B07 09:00 ~ 11:45	S4_202 14:00 ~ 16:45	PA1 09:30 ~ 11:00			
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート		S4_202 14:00 ~ 16:45	S4_202 10:00 ~ 12:15					
9.3 ナノエレクトロニクス	S4_202 09:00 ~ 11:30							
9.4 熱電変換				WL2_401 13:30 ~ 17:45				
9.5 新機能材料・新物性						S4_202 14:00 ~ 17:15		
10 スピントロニクス・マグネティクス								
10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）		PB1 14:30 ~ 16:00					S2_201 09:00 ~ 11:45	S2_201 13:30 ~ 15:45
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術			S4_201 09:00 ~ 12:30	S4_201 14:00 ~ 17:15				
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術				S4_201 17:15 ~ 19:00	M_374 09:00 ~ 12:00			
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス			S2_201 09:00 ~ 12:30	S2_201 14:00 ~ 17:00				
10.5 磁場応用		S2_201 16:30 ~ 18:15						
11 超伝導								
11.1 基礎物性	W9_325 09:30 ~ 11:45	W9_325 13:30 ~ 16:45	PA1 09:30 ~ 11:00					
11.2 薄膜，厚膜，テープ作製プロセスおよび結晶成長				W9_325 13:30 ~ 16:15				
11.3 臨界電流，超伝導パワー応用					W9_323 09:30 ~ 11:30			
11.4 アナログ応用および関連技術				W8E_308 13:30 ~ 15:45				
11.5 接合，回路作製プロセスおよびデジタル応用						W8E_308 13:30 ~ 17:45		
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御			PA7 11:30 ~ 13:00		W2_402 10:00 ~ 11:15	W2_402 13:30 ~ 17:30		
12.2 評価・基礎物性					PB2 11:30 ~ 13:00	M_123 14:00 ~ 18:45	M_123 09:00 ~ 12:30	
12.3 機能材料・萌芽的デバイス			M_103 09:00 ~ 11:30	M_103 14:00 ~ 17:15	M_B104 09:00 ~ 12:00	M_B104 14:00 ~ 17:00	PB1 09:30 ~ 11:00	
12.4 有機EL・トランジスタ・フレキシブルデバイス				M_B104 14:00 ~ 19:00	M_123 09:00 ~ 12:15	PB1 14:30 ~ 16:00	M_B104 09:00 ~ 11:45	M_B104 13:30 ~ 15:45
12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	PA3 09:30 ~ 11:00		M_124 09:00 ~ 12:15	M_124 14:00 ~ 18:30	M_124 09:00 ~ 12:00	M_124 14:00 ~ 15:30		
12.6 ナノバイオテクノロジー	WL1_201 09:00 ~ 12:00		W2_402 09:00 ~ 11:45	W2_402 13:30 ~ 18:15	PB3 11:30 ~ 13:00			
12.7 医用工学・バイオチップ	WL1_301 09:00 ~ 12:00		WL1_301 09:00 ~ 12:00		WL1_301 09:00 ~ 12:00		PB2 09:30 ~ 11:00	W2_401 13:30 ~ 16:30
12.8 特定テーマ：有機無機ハイブリッドペロブスカイトの光電物性・デバイス作製・構造制御						PB2 14:30 ~ 16:00	M_101 10:00 ~ 12:30	M_101 14:00 ~ 16:00

日程表（分科別4）

大分類分科名	3月15日(日)		3月16日(月)		3月17日(火)		3月18日(水)	
中分類分科名	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション					S4_203 09:00 ~ 12:00	PA4 16:30 ~ 18:00		
13.2 探索的材料物性・基礎物性			PA2 09:30 ~ 11:00	W9_323 13:00 ~ 18:30				
13.3 絶縁膜技術	W8E_101 09:00 ~ 11:00	W8E_101 13:30 ~ 17:15	PA3 09:30 ~ 11:00					
CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス／配線／集積化技術のコードシェアセッション					M_278 09:00 ~ 12:30			
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	S4_203 09:00 ~ 12:00	S4_203 14:00 ~ 18:15	PA4 09:30 ~ 11:00		S2_201 09:00 ~ 12:45			
13.5 デバイス／配線／集積化技術	M_124 09:00 ~ 12:30 PB1 09:30 ~ 11:00		S2_203 09:00 ~ 11:45	S2_203 14:00 ~ 18:45	S2_203 09:00 ~ 12:15		S2_203 09:00 ~ 12:00	S2_203 14:00 ~ 17:00
CS.3 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス／配線／集積化技術のコードシェアセッション					M_278 09:00 ~ 12:30			
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス			M_107 09:30 ~ 12:15	M_107 14:00 ~ 17:15		PA5 16:30 ~ 18:00		
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	PB2 09:30 ~ 11:00		W8E_101 09:30 ~ 12:00	W8E_101 13:30 ~ 18:00	W8E_101 09:00 ~ 12:00	W8E_101 13:30 ~ 18:30	W8E_101 09:00 ~ 12:15	W8E_101 13:30 ~ 16:15
13.8 光物性・発光デバイス						PA6 16:30 ~ 18:00	WL2_101 09:00 ~ 12:00	
13.9 化合物太陽電池			PA5 09:30 ~ 11:00	M_101 13:30 ~ 18:30				
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長			PA8 11:30 ~ 13:00	W8E_307 14:00 ~ 17:30				
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶			W8E_308 11:00 ~ 12:00	PA1 14:30 ~ 16:00				
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎				PA2 14:30 ~ 16:00	W8E_307 09:15 ~ 12:00	W8E_307 13:30 ~ 16:15		
15.4 III-V族窒化物結晶	W2_401 09:00 ~ 11:30	W2_401 13:00 ~ 17:45	W2_401 09:00 ~ 11:30	W2_401 13:00 ~ 17:45 PA3 14:30 ~ 16:00	W2_401 09:00 ~ 11:30	W2_401 13:30 ~ 18:30	W2_401 09:00 ~ 12:00	
CS.4 6.1 強誘電体薄膜、15.4 III-V族窒化物結晶のコードシェアセッション		SL_101 13:45 ~ 18:30						
15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	W2_402 10:00 ~ 11:45	W2_402 13:30 ~ 16:45		PA4 14:30 ~ 16:00				
15.6 IV族系化合物（SiC）	PB3 09:30 ~ 11:00	W8E_307 13:30 ~ 17:45						
15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥			W8E_307 09:00 ~ 11:45	PA5 14:30 ~ 16:00				
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	PA5 11:30 ~ 13:00			W9_327 13:30 ~ 18:00				
16.2 エナジーハーベスティング			W9_327 09:00 ~ 10:30					
16.3 シリコン系太陽電池					W9_325 10:00 ~ 11:30	W9_325 13:30 ~ 16:30		
17 ナノカーボン・二次元材料								
17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料		M_101 14:00 ~ 17:00	M_101 09:00 ~ 12:15	PA7 & PB4 16:30 ~ 18:00				
17.2 グラフェン						M_101 14:00 ~ 19:00		
17.3 層状物質		M_124 14:00 ~ 18:15	M_178 09:00 ~ 12:00		M_178 09:00 ~ 12:30	M_178 14:00 ~ 18:00	M_178 09:00 ~ 12:00	M_178 14:00 ~ 16:00
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」		W9_324 13:30 ~ 17:15	W9_324 09:00 ~ 12:15	W9_324 13:30 ~ 18:30	W9_324 09:15 ~ 12:00	W9_324 13:30 ~ 17:45	PA3 11:30 ~ 13:00	
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	W9_323 10:30 ~ 11:45	W9_323 13:30 ~ 17:15	W9_325 10:00 ~ 12:00	PA6 14:30 ~ 16:00				
23 合同セッションN「インフォマティクス応用」								
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」		S2_204 13:30 ~ 18:30			S2_204 09:00 ~ 12:30	S2_204 13:30 ~ 18:30	PA1 09:30 ~ 11:00	S2_204 14:00 ~ 16:45
							S2_204 11:30 ~ 13:00	